

# Bibliographic data: JP 2002151263 (A)

#### ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Publication date:

2002-05-24

Inventor(s):

AZUMAGUCHI TATSU; ISHIKAWA HITOSHI; TADA HIROSHI; ODA ATSUSHI 🕸

Applicant(s):

NEC CORP ±

-

**C09K11/06; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22; H05B33/26;** (IPC1-7): C09K11/06; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22; H05B33/26

Classification: in

international: H05B33/26;

- European:

Application number:

JP20000339603 20001107

**Priority number** 

(s):

JP20000339603 20001107

Also published

• JP 3548841 (B2)

# Abstract of JP 2002151263 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element with excellent light-emitting characteristics, SOLUTION: At least one layer of organic thin film layers contains a specific compound represented by the formula A, either by liself or as a mixture.

Last updated: 04,04,2011 Worldwide Database 5,7,20; 93p

[A]

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-151263 (P2002-151263A)

(43)公開日 平成14年5月24日(2002.5.24)

(51) Int.Cl.		識別記号		FΙ				テーマコード(参考)			
H05B	33/14			H0	5 B	33/14		В	3 K 0	0 7	
C09K	11/06	6 2 5		C 0	9 K	11/06		6 2 5			
H05B	33/10			H 0 5 B 33/10							
	33/22			33/22			В				
							D				
			審査請求	有	請求	で項の数10	OL	(全 25 頁	<b>最終</b>	頁に続く	
(21)出願番号		特願2000-339603(P2000-339603)		(71)	(71)出願人 000004237 日本電気株式会社						
(22)出顧日		平成12年11月7日(2000.11.7)		東京都港区芝				五丁目7番1号			
						東京都式会社		五丁目7番:	1号 日本	電気株	
				(72)	発明者	皆 石川 。	仁志				
						東京都	港区芝	五丁目7番	1号 日本	電気株	
						式会社	内				
				(74)	代理人	100108	578				
						弁理士	髙橋	韶男 (外	43名)		

[A] ...

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

# (57)【要約】

【課題】 発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセ ンス素子を提供する。

【解決手段】 本発明の有機エレクトロルミネッセンス 素子において、少なくとも一層の有機薄膜層が、下記一 般式 [A] で表される特定の化合物を単独で、もしくは 混合物として含有する。

【化1】

(4)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と陰極間に、発光層を含む一層又は複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が下記・般式 [A] で表される化合物を単独で、もしくは混合物として含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

1

[
$$\{$$
L 1 ]  
 $R^{6}$   $R^{7}$   $R^{13}$   $R^{14}$   $R^{15}$   
 $R^{6}$   $R^{8}$   $R^{13}$   $R^{14}$   $R^{15}$   
 $R^{9}$   $R^{10}$   $R^{12}$   $R^{14}$   $R^{15}$   $R^{16}$   
 $R^{17}$   $R^{18}$   
 $R^{10}$   $R^{10}$ 

(但し、式 [A] 中、 $Ar^1$  は炭素数 5 から 42 の置換 もしくは無置換の芳香族炭化水素基あるいは置換もしくは無置換の芳香族複素環基を表し、 $Ar^2$  ~ $Ar^5$  はそれぞれ独立に炭素数 6 から 20 の置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基あるいは置換もしくは無置換の芳香族複素環基を表す。また、 $X^1$  及び $X^2$  はそれぞれ独立に二価の連結基を表す。また、 $R^1$  ~ $R^{20}$  はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアミノ

R24 R23 R22 Ar4 R70 R61 Ar2 R<sup>69</sup> R62 N-Ar1 Ar<sup>5</sup> R64 R<sup>66</sup> **173** R74 R<sup>76</sup>  $R^{35}$  $R^{75}$  $R^{36}$ (B)

(但し、式[B]中、Ar<sup>1</sup>は炭素数5から42の置換 もしくは無置換の芳香族炭化水素基あるいは置換もしく は無置換の芳香族複素環基を表し、Ar<sup>2</sup>~Ar<sup>3</sup>はそれ ぞれ独立に炭素数6から20の置換もしくは無置換の芳 香族炭化水素基あるいは置換もしくは無置換の芳香族複 素環基を表す。また、R<sup>21</sup> からR<sup>76</sup> はそれぞれ独立に水 素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアミノ 基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無 置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のシクロアル キル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もし くは無置換の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の 芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、 置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは 無置換のアルコキシカルボニル基を表し、 $R^{21} \sim R^{30}$  $R^{31} \sim R^{40}$ 、 $R^{41} \sim R^{50}$ 、 $R^{51} \sim R^{60}$  及び $R^{61} \sim R^{76}$  は それらのうちの2つで環を形成してもよい。また、Ar <sup>2</sup>とAr<sup>3</sup>、Ar<sup>1</sup>とAr<sup>3</sup>はお互い環を形成してもよ

\*基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル基を表し、R¹~R¹®及びR'¹~R² はそれらのうちの2つで環を形成してもよい。また、Ar²とAr³、Ar⁴とAr⁵はお互い環を形

【請求項2】 前記一般式 [A] において、X<sup>1</sup>及びX<sup>2</sup> で表される連結基の少なくとも1つが、置換もしくは無置換のスチリル基であることを特徴とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 陽極と陰極間に、発光層を含む一層又は 複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセ ンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が 下記一般式 [B] で表される化合物を単独で、もしくは 混合物として含有することを特徴とする有機エレクトロ 20 ルミネッセンス素子。

【化2】

い。)

【請求項4】 前記発光層が前記一般式 [A] 又は前記一般式 [B] で表される化合物を単独で、もしくは混合物として含有することを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

40 【請求項5】 前記有機薄膜層として電子輸送層を有するとともに、該電子輸送層が前記一般式 [A] 又は前記一般式 [B] で表される化合物を単独で、もしくは混合物として含有することを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 前記有機薄膜層として正孔輸送層を有するとともに、該正孔輸送層が前記一般式 [A] 又は前記一般式 [B] で表される化合物を単独で、もしくは混合物として含有することを特徴とする請求項1から請求項50 3までのいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッ

センス素子。

【請求項7】 前記発光層が前記陽極に隣接していることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 前記陽極が、波長200nm未満の紫外線照射処理を施した陽極からなることを特徴とする請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】 前記陽極が、酸素プラズマ処理を施した 陽極からなることを特徴とする請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項10】 前記陰極に隣接する前記有機薄膜層が、前記陰極との界面に、金属を含有することを特徴とする請求項1から請求項9までのいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光特性に優れた 有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス素子(以 20下、「有機 E L 素子」と略記することもある。)は、電界印加時に、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子との再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。

【0003】イーストマン・コダック社のC. W. Tangらによって積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告(C.W.Tang, S.A.VanSlyke, Applied Physics Letters, 51巻,913頁、1987年など)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子に関する研究が盛んに行われている。

【0004】Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキ ノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジ アミン誘導体を正孔輸送層に用いている。積層構造の利 点としては、発光層への正孔の注入効率を高めることが できる、陰極より注入された電子をブロックして再結合 により生成する励起子の生成効率を高めることができ る、発光層内で生成した励起子を閉じこめることができ る等を挙げることができる。この例のように、有機 EL 素子の素子構造としては、正孔輸送(注入)層、電子輸 送性発光層の2層型、又は正孔輸送(注入)層、発光 層、電子輸送(注入)層の3層型等がよく知られてい る。こうした積層構造型の有機 E L素子では、注入され た正孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や各 層の形成方法の工夫がなされている。また、材料に関し ても様々な化合物が有機EL素子用材料として開発され ている。

【0005】正孔輸送性材料としてはスターバースト分子である4,4',4"ートリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミンやN,N'ージフェニル-N,N'ービス(3-メチルフェニル)ー

[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン等のトリフェニルアミン誘導体や芳香族ジアミン誘導体がよく知られている(例えば、特開平8-20771号公報、特開平8-40997号公報、特開平8-53397号公報、特開平8-87122号公報等)。また、電子輸送性材料としてはオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体等がよく知られ

【0006】また、発光材料としては、トリス(8-キ 10 ノリノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られ、それらの発光色も青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-138561号公報、特開平3-200289号公報等)。

[0007]

ている。

【発明が解決しようとする課題】上記の他にも多数の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料が報告されているが、特定の化合物において、分子間の相互作用が強すぎるために、成膜に使用できるプロセスに制限があるという問題があった。また、こうした分子間相互作用の強い材料を発光材料として用いた場合、濃度消光による発光輝度の低下が見られ、充分な発光輝度、発光効率が得られないという問題点があった。

【0008】そこで、本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、成膜プロセスに制限がなく、かつ充分な発光輝度、発光効率が得られ、発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定のジアリールアミノ基、具体的にはシクロヘキシリデンメチン基を有するビス(ジアリールアミノ)アリーレン化合物は、シクロヘキシリデンメチン基がもたらす立体障害の効果により分子間相互作用が弱められるため、成膜時のプロセスに関する制限を解決し、かつ発光材料として用いた場合にも濃度消光をおこさず発光特性が向上することを見出し、以下の本発明のエレクトロルミネッセンス素子を発明するに到った。

【0010】本発明の第1の有機エレクトロルミネッセンス素子は、陽極と陰極間に、発光層を含む一層又は複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が下記一般式[A]で表される化合物を単独で、もしくは混合物として含有することを特徴とする。

[0011]

50 【化3】

4

(但し、式「A]中、Ar<sup>1</sup>は炭素数5から42の置換 もしくは無置換の芳香族炭化水素基あるいは置換もしく は無置換の芳香族複素環基を表し、Ar<sup>2</sup>~Ar<sup>5</sup>はそれ ぞれ独立に炭素数6から20の置換もしくは無置換の芳 10 香族炭化水素基あるいは置換もしくは無置換の芳香族複 素環基を表す。また、 $X^1$ 及び $X^2$ はそれぞれ独立に二価 の連結基を表す。また、 $R^1 \sim R^{\infty}$  はそれぞれ独立に水 素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアミノ 基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無 置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のシクロアル キル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もし くは無置換の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の\*

\* 芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、  
置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは  
無置換のアルコキシカルボニル基を表し、
$$R^1 \sim R^{10}$$
 及  
び $R^{11} \sim R^{20}$  はそれらのうちの2つで環を形成してもよ  
い。また、 $A r^2 と A r^3$ 、 $A r^4 と A r^5$  はお互い環を形  
成してもよい。)

6

また、前記一般式 [A] において、X DびX で表され る連結基の少なくとも1つが、置換もしくは無置換のス チリル基であることが望ましい。

【0012】本発明の第2の有機エレクトロルミネッセ ンス素子は、陽極と陰極間に、発光層を含む一層又は複 数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセン ス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が下 記一般式 [B] で表される化合物を単独で、もしくは混 合物として含有することを特徴とする。

[0013] 【化4】

(但し、式 [B] 中、Ar<sup>1</sup>は炭素数5から42の置換 もしくは無置換の芳香族炭化水素基あるいは置換もしく は無置換の芳香族複素環基を表し、Ar<sup>2</sup>~Ar<sup>3</sup>はそれ ぞれ独立に炭素数6から20の置換もしくは無置換の芳 香族炭化水素基あるいは置換もしくは無置換の芳香族複 素環基を表す。また、 $R^{21}$  から  $R^{70}$  はそれぞれ独立に水 素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアミノ 基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無 置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のシクロアル キル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もし くは無置換の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の 40 芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、 置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは 無置換のアルコキシカルボニル基を表し、 $R^{21} \sim R^{3}$  $R^{31} \sim R^{40}$ 、 $R^{41} \sim R^{50}$ 、 $R^{51} \sim R^{60}$  及び $R^{61} \sim R^{76}$  は それらのうちの2つで環を形成してもよい。また、Ar ²とAr³、Ar⁴とAr゚はお互い環を形成してもよ い。)

【0014】また、上記本発明の第1、第2の有機エレ クトロルミネッセンス素子において、前記発光層が前記 一般式 [A] 又は前記一般式 [B] で表される化合物を 50 く、このような構成にすることにより、より優れた発光

単独で、もしくは混合物として含有することを特徴とす る。

【0015】また、本発明の上記一般式 [A] 又は一般 式「B」で表される化合物は優れた電荷輸送特性を有し ており、これを電子輸送材料として用いた場合にも優れ た発光特性を有することを見出した。したがって、前記 有機薄膜層として電子輸送層を有する場合には、電子輸 送層に前記一般式[A]又は前記一般式[B]で表され る化合物を単独で、もしくは混合物として含有させる構 成としても良い。

【0016】また、本発明の上記一般式 [A] 又は一般 式「B]で表される化合物は優れた電荷輸送特性を有し ており、これを正孔輸送材料として用いた素子は優れた 発光特性を有することを見出した。したがって、前記有 機薄膜層として正孔輸送層を有する場合には、正孔輸送 層に前記一般式 [A] 又は前記一般式 [B] で表される 化合物を単独で、もしくは混合物として含有させる構成 としても良い。

【0017】また、前記陰極に隣接する前記有機薄膜層 が、前記陰極との界面に、金属を含有することが望まし

特性を得ることができることを見出した。また、本発明は、特に発光層が陽極に隣接している場合に有効であり、より優れた発光特性を得ことができることを見出した

【0018】また、本発明の化合物を用い、発光層が陽極に隣接する構造の素子においては、有機薄膜層の形成前に、陽極に波長200nm未満の紫外線照射処理、あるいは酸素プラズマ処理を施すことにより、より優れた発光特性を得ることができることを見出した。したがって、発光層が陽極に隣接する構造の素子においては、前10記陽極を、波長200nm未満の紫外線照射処理を施した陽極、あるいは酸素プラズマ処理を施した陽極により構成することが望ましい。

 $R^{35}$ 

H36:

[0019]

R<sup>24</sup> R<sup>23</sup> R<sup>22</sup>
R<sup>25</sup>
R<sup>26</sup>
R<sup>27</sup>
R<sup>26</sup>
R<sup>27</sup>
R<sup>28</sup>
R<sup>28</sup>
R<sup>28</sup>
R<sup>28</sup>
R<sup>28</sup>
R<sup>28</sup>
R<sup>29</sup>
R<sup>28</sup>
R<sup>29</sup>

R75

【0021】上記一般式 [A]、 [B] において、Ar は炭素数5~42の置換もしくは無置換の芳香族炭化 水素基または置換もしくは無置換の芳香族複素環基を示 す。例としては、ナフチル基、アントラニル基、ペリレ ニレン基、1:2ベンゾペリレニレン基、1:2:7: 8ジベンゾペリレニレン基、1:2:11:12ジベン ゾペリレニレン基、テリレニレン基、ペンタセニレン 基、ビスアンスレニレン基、10,10'-(9,9' ービアンスリル)イレン基、4,4'-(1,1'-ビナ フチル)イレン基、4,10'-(1,9'-ナフチルア ンスリル)イレン基、一般式 $-Ar^{6}-Ar^{7}-Ar^{8}-$ で 表される2価基(但し、Ar<sup>6</sup>~Ar<sup>8</sup>はそれぞれナフチ ル基またはアントラニル基の何れかを示す。)、及びフ ェナントレン、ピレン、ビフェニル、ターフェニル等の 芳香族炭化水素あるいは縮合多環式炭化水素、カルバゾ 40 ール、ピロール、チオフェン、フラン、イミダゾール、 ピラゾール、イソチアゾール、イソオキサゾール、ピリ ジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、フラザン、 チアンスレン、イソベンゾフラン、フェノキサジン、イ ンドリジン、インドール、イソインドール、1 Hーイン ダゾール、プリン、キノリン、イソキノリン、フタラジ ン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノ リン、プテリジン、カルバゾール、βーカルバゾリン、 フェナンスリジン、アクリジン、ペリミジン、フェナン トロリン、フェナジン、フェノチアジン、フェノキサジ 50

\*【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の第1の化合物は、下記一般式[A]で表される 構造を有する化合物である。

[ $\{1,5\}$ ]  $R^{5}$   $R^{5}$   $R^{6}$   $R^{7}$   $R^{10}$   $R^{10}$ 

【0020】また、本発明の第2の化合物は、下記一般式[B]で表される構造を有する化合物である。 【化6】

ン等の複素環化合物あるいは縮合複素環化合物の水素原 子を2個除いた二価の基及びそれらの誘導体が挙げられ る。

R<sup>59</sup> R<sup>58</sup> R<sup>57</sup>

【0022】Ar<sup>2</sup>~Ar<sup>5</sup>は、それぞれ独立に置換もし くは無置換の炭素数6~20の芳香族炭化水素基あるい は置換もしくは無置換の炭素数4~20の芳香族複素環 基を示す。炭素数6~20の芳香族炭化水素基の例とし ては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナ ントリル基、ナフタセニル基、ピレニル基等が挙げられ る。炭素数4~20の芳香族複素環基の例としては、ピ ロリル基、ピラジニル基、ピリジニル基、インドリル 基、イソインドリル基、フリル基、ベンゾフラニル基、 キノリル基、フェナンスリジニル基等が挙げられる。 【0023】また、Ar<sup>1</sup>~Ar<sup>8</sup>の有する置換基として は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトロ 基、シアノ基、置換もしくは無置換のアミノ基、置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアル ケニル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置 換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換 の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の芳香族複素 環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしく は無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のア ルコキシカルボニル基、カルボキシル基が挙げられる。 【0024】上記一般式 [A] において、X<sup>1</sup>及びX<sup>2</sup>は 2価の連結基を表す。連結基の例としては、単結合の

他、置換もしくは無置換のアミノ基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル基、置換もしくは無置換のスチリル基から、さらに水素原子を1つ取り除いて得られる二価基が挙げられる。特に、X¹及びX²で表される連結基の少なくとも101つが、置換もしくは無置換のスチリル基であることが望ましい。

【 O O 2 5 】上記一般式 [ A ] 、 [ B ] において、R '

 $\sim$ R $^{20}$ 、R $^{21}$   $\sim$ R $^{76}$  は、それぞれ独立に水素原子、ハロ ゲン原子、置換もしくは無置換のアミノ基、置換もしく は無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルケニ ル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、置換も しくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換の芳 香族炭化水素基、置換もしくは無置換の芳香族複素環 基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは 無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアル コキシカルボニル基を表し、R'~R"、R"~R<sup>20</sup>、  $R^{21} \sim R^{30}$  ,  $R^{31} \sim R^{40}$  ,  $R^{41} \sim R^{50}$  ,  $R^{51} \sim R^{60}$  , R<sup>61</sup> ~ R <sup>76</sup> はそれらのうちの2つで環を形成してもよい。 【0026】ここに、ハロゲン原子の例としては、フッ 素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられ る。置換若しくは無置換のアルキル基としては、メチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ ル基、sーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、n ーペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブ チル基、1.2-ジヒドロキシエチル基、1.3-ジヒ ドロキシイソプロピル基、2、3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1、2、3-トリヒドロキシプロピル基、ク ロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル 基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル 基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロ ロー t ーブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル 基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモ 40 エチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモ エチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモ t ーブチル基、1,2,3-トリブロモプロピ ル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨー ドエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョー ドエチル基、1、3-ジョードイソプロピル基、2.3 -ジョード t -ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロ ピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジア

ミノエチル基、1、3-ジアミノイソプロピル基、2、

3-ジアミノtーブチル基、1,2,3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2,3-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノtーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトロ tーブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0027】置換若しくは無置換のアルケニル基としては、ビニル基、アリル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1,3-ブタンジエニル基、1-メチルビニル基、スチリル基、2,2-ジフェニルビニル基、1,2-ジメチルアリル基、2-メチルアリル基、3-フェニルアリル基、3-ジフェニルアリル基、3-フェニルアリル基、3-ブフェニルアリル基、1,2-ジメチルアリル基、1-フェニルアリル基、1-フェニルー1-ブテニル基、3-フェニルー1-ブテニル基、3-フェニルー1-ブテニル基、3-フェニルー1-ブテニル基、3-フェニルー1-ブテニル基等が挙げられる。【0028】置換若しくは無置換のシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等が挙げられる。

【0029】置換若しくは無置換のアルコキシ基は、一 般式-OYで表される基であり、Yとしては、メチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ ル基、sーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、n ーペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブ チル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒ ドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、ク ロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル 基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル 基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロ ローtーブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル 基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモ エチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモ エチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモ t ーブチル基、1,2,3-トリブロモプロピ ル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨー ドエチル基、2-ヨードイソブチル基、1.2-ジヨー ドエチル基、1.3-ジョードイソプロピル基、2.3 -ジョードtーブチル基、1、2、3ートリヨードプロ ピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジア ミノエチル基、1、3-ジアミノイソプロピル基、2、 50 3 ージアミノ t ーブチル基、1, 2, 3 ートリアミノプ

ロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジ シアノエチル基、1、3-ジシアノイソプロピル基、 2, 3-ジシアノ t - ブチル基、1, 2, 3-トリシア ノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、 2-二トロエチル基、2-二トロイソブチル基、1、2 -ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル 基、2、3-ジニトロt-ブチル基、1、2、3-トリ ニトロプロピル基等が挙げられる。

例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチ ル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アン トリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル 基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9 -フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタ セニル基、9ーナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4ーピレニル基、2-ビフェニルイル基、 3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-タ ーフェニルー4-イル基、p-ターフェニル-3-イル 基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル 20 スロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9 - 4 ーイル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-タ ーフェニルー2-イル基、o-トリル基、m-トリル 基、pートリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル -1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、 4''-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基等が 挙げられる。

【0031】また、置換若しくは無置換の芳香族複素環 基としては、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピ ロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリ ジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、 5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル 基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3 -イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラ ニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル 基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7 40 -ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5 ーイソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、 7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリ ル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノ リル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5 ーイソキノリル基、6ーイソキノリル基、7ーイソキノ リル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、 5ーキノキサリニル基、6ーキノキサリニル基、1ーカ 50 ェナジニル基、2ーフェナジニル基、1ーフェノチアジ

12

ルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル 基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フ ェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6 ーフェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、 8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル 基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル 基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-ア クリジニル基、9-アクリジニル基、1、7-フェナン 【0030】置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の 10 スロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3 ーイル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、 1. 7-フェナンスロリン-5-イル基、1. 7-フェ ナンスロリン-6-イル基、1、7-フェナンスロリン -8-イル基、1、7-フェナンスロリン-9-イル 基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8 ーフェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンス ロリン-3-イル基、1、8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェナン ーイル基、1、8-フェナンスロリン-10-イル基、 1.9-フェナンスロリン-2-イル基、1.9-フェ ナンスロリン-3-イル基、1.9-フェナンスロリン - 4 - イル基、1、9 - フェナンスロリン - 5 - イル 基、1、9-フェナンスロリン-6-イル基、1、9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロ リン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1、10-フェナンスロリン-2-イル基、 1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-30 フェナンスロリンー4ーイル基、1,10ーフェナンス ロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-1-イル基、2、9-フェナンスロリン-3-イル基、2、 9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナン スロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-6 ーイル基、2、9-フェナンスロリン-7-イル基、 2. 9-フェナンスロリン-8-イル基、2. 9-フェ ナンスロリン-10-イル基、2、8-フェナンスロリ ン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル 基、2、8-フェナンスロリン-4-イル基、2、8-フェナンスロリンー5-イル基、2,8-フェナンスロ リン-6-イル基、2、8-フェナンスロリン-7-イ ル基、2、8-フェナンスロリン-9-イル基、2、8 ーフェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナン スロリン-1-イル基、2、7-フェナンスロリン-3 ーイル基、2、7-フェナンスロリン-4-イル基、 2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェ ナンスロリン-6-イル基、2、7-フェナンスロリン -8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル 基、2、7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フ

ニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニ ル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニ ル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサ ジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニ ル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピ ロールー1ーイル基、2ーメチルピロールー3ーイル 基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロ 10 ールー5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、 3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール -4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2t - ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニル プロピル) ピロールー1-イル基、2-メチル-1-イ ンドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチ ルー3-インドリル基、4-メチルー3-インドリル 基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル 1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、 4-t-ブチル3-インドリル基、等が挙げられる。 【0032】置換若しくは無置換のアラルキル基として は、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニル エチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニル イソプロピル基、フェニルー t ーブチル基、αーナフチ ルメチル基、 $1-\alpha-$ ナフチルエチル基、 $2-\alpha-$ ナフ チルエチル基、1-α-ナフチルイソプロピル基、2αーナフチルイソプロピル基、βーナフチルメチル基、  $1-\beta-$ ナフチルエチル基、 $2-\beta-$ ナフチルエチル 基、1-β-ナフチルイソプロピル基、2-β-ナフチ ルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル) エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチ ルベンジル基、oーメチルベンジル基、pークロロベン ジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル 基、p-ブロモベンジル基、m-ブロモベンジル基、o -ブロモベンジル基、p-ヨードベンジル基、m-ヨー ドベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシ ベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキ シベンジル基、pーアミノベンジル基、mーアミノベン ジル基、oーアミノベンジル基、pーニトロベンジル 基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p 40 ーシアノベンジル基、mーシアノベンジル基、oーシア ノベンジル基、1-ヒドロキシー2-フェニルイソプロ ピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が 挙げられる。

フタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル 基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル 基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4 ービフェニルイル基、p-ターフェニルー4-イル基、 p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2 ーイル基、m-ターフェニルー4-イル基、m-ターフ ェニルー3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、 oートリル基、mートリル基、pートリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェ ニル基、3-メチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ー ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メ チルビフェニルイル基、4''-t-ブチル-p-ターフ ェニルー4ーイル基、2ーピロリル基、3ーピロリル 基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル 基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インド リル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-イ ンドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル 基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5 -イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソ インドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベン ゾフラニル基、3ーベンゾフラニル基、4ーベンゾフラ ニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル 基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル 基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニ ル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラ ニル基、7ーイソベンゾフラニル基、2ーキノリル基、 3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6 ーキノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリ ル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリ ニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル 基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カ ルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリ ジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンス リジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナン スリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナ ンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フ ェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリ ジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、 9-アクリジニル基、1、7-フェナンスロリン-2-イル基、1.7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナン スロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6 ーイル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、 1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェ ナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリ ン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル 基、1、8-フェナンスロリン-4-イル基、1、8-

リンー6ーイル基、1、8-フェナンスロリン-7-イ ル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8 -フェナンスロリン-10-イル基、1、9-フェナン スロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3 ーイル基、1,9ーフェナンスロリン-4ーイル基、 1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェ ナンスロリンー6-イル基、1,9-フェナンスロリン -7-イル基、1、9-フェナンスロリン-8-イル 基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,1 ンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン -4-イル基、1、10-フェナンスロリン-5-イル 基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロ リンー4-イル基、2、9-フェナンスロリン-5-イ ル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9 -フェナンスロリン-7-イル基、2,9-フェナンス ロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン-10 ーイル基、2,8ーフェナンスロリン-1ーイル基、 ナンスロリンー4ーイル基、2、8-フェナンスロリン -5-イル基、2、8-フェナンスロリン-6-イル 基、2、8-フェナンスロリン-7-イル基、2、8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロ リン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2、7-フェナンスロリン-3-イル基、2、 7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェナン スロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6 ーイル基、2,7ーフェナンスロリン-8ーイル基、 2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェ 30 シアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、 ナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2 -フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェ ノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノ チアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキ サジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサ ジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、 5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オ キサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル 基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル 基、2ーメチルピロールー3ーイル基、2ーメチルピロ 40 ールー4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、 3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール -2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-t-ブチルピロール -4-イル基、3-(2-フェニルプロピル) ピロール -1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メ

チルー1ーインドリル基、2ーメチルー3ーインドリル

基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1

ーインドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2

-t-ブチル3-インドリル基、4-t-ブチル3-イ 50

ンドリル基等が挙げられる。

【0034】置換若しくは無置換のアルコキシカルボニ ル基は、一般式一COOYで表され、Yとしてはメチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチ ル基、sーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、n ーペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブ チル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒ 0-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナ 10 ドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1、2、3-トリヒドロキシプロピル基、ク ロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル 基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル 基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロ ローtーブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル 基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモ エチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモ エチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモ t ーブチル基、1、2、3-トリブロモプロピ 2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェ 20 ル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨー ドエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョー ドエチル基、1、3-ジョードイソプロピル基、2、3 ージヨード t ーブチル基、1、2、3-トリヨードプロ ピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1.2-ジア ミノエチル基、1、3-ジアミノイソプロピル基、2、 3-ジアミノt-ブチル基、1,2,3-トリアミノプ ロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1、2-ジ 2, 3-ジシアノt-ブチル基、1, 2, 3-トリシア ノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、 2-二トロエチル基、2-二トロイソブチル基、1.2 -ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル 基、2,3-ジニトロt-ブチル基、1,2,3-トリ ニトロプロピル基等が挙げられる。

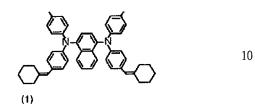
> 【0035】また、環を形成する2価基の例としては、 テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン 基、ジフェニルメタン-2、2'-ジイル基、ジフェニ ルエタン-3,3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4, 4'-ジイル基等が挙げられる。

> 【0036】置換もしくは無置換のアミノ基は、一般式  $-NX^3X^4$ で表され、 $X^3$ 、 $X^4$ としてはそれぞれ独立 に、水素原子、前述の置換もしくは無置換のアルキル 基、前述の置換もしくは無置換のアルケニル基、置換も しくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換の芳 香族炭化水素基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基 等が挙げられる。

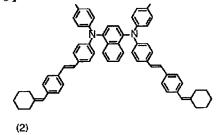
> 【0037】以下に本発明の化合物例として、化合物 (1)~(44)を挙げるが、本発明はその要旨を越え

ない限りこれらに限定されるものではない。なお、化合物  $(1) \sim (44)$  において、一般式 [B] で表されるものは化合物 (4) 、(5) 、(9) 、(13) 、(17) 、(21) 、(25) 、(29) 、(33) 、(37) 、(41) 、(44) であり、それ以外は、一般式[A] で表される化合物である。

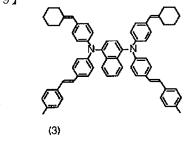
【化7】



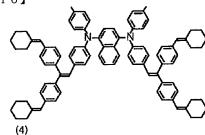
【化8】



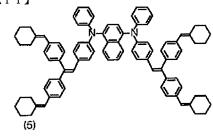
【化9】



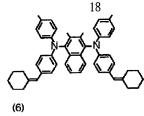
【化10】



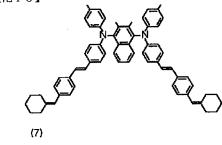
【化11】



10



【化13】

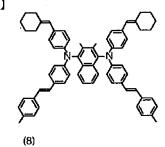


【化14】

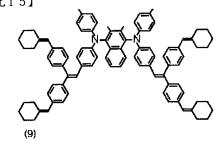
20

30

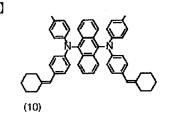
40



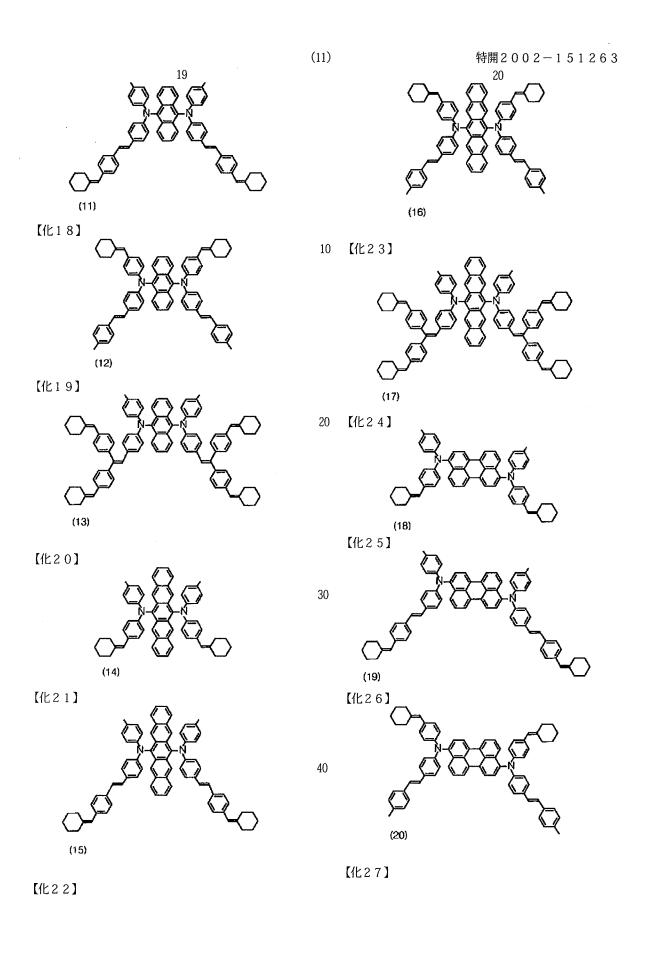
【化15】



【化16】



【化17】



【0038】次に、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)の構造について説明する。本発明の有機EL素子は、陽極と陰極間に、発光層を含む一層又は複数層の有機薄膜層を挟持した構造を有する。以下、図1~図4に基づいて、本発明の有機EL素子の構成例について説明する。図1~図4は、本発明の有機EL素子の概略断面図であり、同じ構成要素については同じ参照符号を付している。図1~図4において、符号1は基板、符号2は陽極、符号3は正孔輸送層、符号4は発光層、符号5は電子輸送層、符号6は陰極をそれぞれ示しており、正孔輸送層、発光層、電子輸送層が有機薄膜層からなっている。

【0039】本発明の有機EL素子は、図1~図4に示すように、基板1の表面上に陽極2と発光層4と陰極6を順次積層形成したものを基本構造としており、本発明の有機EL素子としては、図1に示すように、陽極2と陰極6との間に発光層4のみを具備する素子構造、図2に示すように、陽極2と発光層4との間、陰極6と発光層4との間に正孔輸送層3を電子輸送層5を具備する素子構造、図3に示すように、陽極2と発光層4との間に正孔輸送層3を具備し、陰極6と発光層4との間に電子輸送層を具備しない素子構造、あるいは、図4に示すように、陰極6と発光層4との間に電子輸送層5を具備し、陽極2と発光層4との間に正孔輸送層5を具備し、陽極2と発光層4との間に正孔輸送層を具備しない素子構造等を採用することができる。

【0040】本発明の有機EL素子において、上記一般式「A】又は一般式[B]で表される本発明の化合物

が、陽極2と陰極6との間に挟持された上記有機薄膜層 (正孔輸送層3、発光層4、電子輸送層5)のうち少な くとも一層に、単独で、もしくは混合物として含有され ている。

【0041】なお、本発明の化合物を含有する有機薄膜層は、本発明の化合物を含有していればよいので、本発明の化合物のみから構成されていても良いし、他の正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料に本発明の化合物をドープしたものにより構成してもよい。

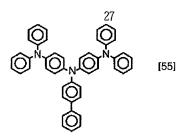
10 【0042】正孔輸送層3に用いられる正孔輸送材料は特に限定されず、通常正孔輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下記のビス(ジ(pートリル)アミノフェニル)ー1,1ーシクロヘキサン[51]、N,N 'ージフェニルーN,N'ービス(3ーメチルフェニル)ー1,1 'ービフェニルー4,4'ージアミン[52]、N,N 'ージフェニルーNーNービス(1ーナフチル)ー1,1'ービフェニル)ー4,4 'ージアミン[53]等のトリフェニルジアミン類や、スターバースト型分子([54]~[5206]等)等が挙げられる。

[0043]

【化55】

50

20



【0044】また、電子輸送層5に用いられる電子輸送材料は特に限定されず、通常電子輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール [57]、ビス $\{2-(4-$ t-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール $\}$  -m-フェニレン [58]、等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体([59]、[60]等)、キノリノール系の金属錯体([61]~[64]等)が挙げられる。

[0045]

【化57】

[
$$\{L \le 8\}$$
]

 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

[
$$(\text{H} 6 0)$$
]

 $(\text{H}_3)$ 
 $(\text{H}_3)$ 
 $(\text{CH}_3)$ 
 $(\text$ 

【化61】

【0046】本発明の有機EL素子の陽極2は、正孔を発光帯域へ注入する役割を担うものであり、4.5 eV30以上の仕事関数を有するものであることが望ましい。本発明に用いられる陽極材料としては、酸化インジウム場合金(以下、「ITO」と称す。)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等を例示することができる。

【0047】また、陰極6としては、電子輸送帯域又は発光帯域に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料を用いることが好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウムーブルミニウム合金、アルミニウムーリチウム合金、アル3ニウムースカンジウムーリチウム合金、マグネシウムー銀合金等が使用できる。

【0048】本発明の有機EL素子の各有機薄膜層の形成方法は特に限定されないが、公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等、一般的な薄膜形成方法を用いることが可能である。本発明の有機EL素子において、前記一般式[A]又は一般式[B]で示される化合物を含有する有機薄膜層は、溶媒に溶かした化合物溶液を塗布するディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法の

50 他、分子間相互作用の強い化合物においては充分な成膜

(16)

速度が得られない、あるいは全く成膜できないために適 用不可能である真空蒸着法、分子線蒸着法 (MBE法) 等の方法でも形成することができる。本発明の有機 E L 素子の各有機薄膜層の膜厚は特に制限されないが、一般 に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、 逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くな るため、通常は数 n mから 1 μ mの範囲が好ましい。

【0049】また、陰極6に隣接する有機薄膜層が、陰 極6との界面に金属を含有することが望ましく、陰極6 6に用いられる金属あるいは合金の他、セシウム、リチ ウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム等が挙げ られるが特にこれに限定されない。

【0050】以上の構成を採用することにより、成膜プ ロセスに制限がなく、かつ充分な発光輝度、発光効率が 得られ、発光特性に優れた有機EL素子を提供すること ができる。また、本発明は、図1~図4に示した有機E L素子の中でも、特に、発光層 4 が陽極 2 に隣接してい る構造のものに有効であり、より優れた発光特性を得る ことができる。

【0051】また、本発明の化合物を用い、発光層4が 陽極2に隣接する構造の素子においては、有機薄膜層を 形成する前の陽極2に対して、波長200nm未満の紫 外線照射処理を施しておくことが望ましい。このよう に、あらかじめ陽極2に紫外線照射処理を施すことによ り、より優れた発光特性を得ることができる。陽極2を 処理するための紫外線照射用ランプとしては、波長20 0 n m未満の波長の光を発し、照射強度が 1 mW/c m <sup>2</sup>以上のものであればどのようなものでもよい。具体的 にはエキシマUVランプ、エキシマレーザー、重水素ラ 30 ンプ等が挙げられるが、これに限定されることはない。 また、陽極2に対する波長200nm未満の紫外線照射 処理は、湿式洗浄法やオゾンクリーニング、あるいは酸 素等のプラズマ照射処理等を事前に施すことによって更 なる効果を得ることができる。

#### [0052]

【実施例】以下、本発明を、実施例をもとに詳細に説明 するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施 例に限定されない。

【0053】(合成例1) N-4-シクロヘキシリデ 40 ル)フェニルーN-フェニルアミンを得た。 ンメチンーフェニルーNーpートリルアミンの合成 4-ブロモベンジルブロマイドと1等量の亜リン酸トリ エチルを反応容器に入れ、攪拌しながら6時間140℃ に加熱した。得られた混合物から減圧蒸留により残った 亜リン酸トリエチルを取り除き、亜リン酸-4-ブロモ ベンジルジエチルを得た。これに1等量のシクロヘキサ ノンと1.2等量の水素化ナトリウムをトルエンージメ チルスルホキシド混合溶媒中、穏やかに加熱しながら反 応させた。

【0054】得られた反応混合物を常法に従い精製し、

4-シクロヘキシリデンメチンフェニルブロミドを得 た。これと1等量のp-トルイジン、1当量の炭酸カリ ウム、銅粉末及びニトロベンゼンを三ツロフラスコに入 れ、200℃で30時間攪拌した。反応終了後、トルエ ンを加えてろ過し、無機物を除いた。トルエン及びニト ロベンゼンを減圧下で留去し、残さを常法に従い分離精 製して目的のN-4-シクロヘキシリデンメチンーフェ ニルーN-p-トリルアミンを得た。

【0055】(合成例2) N-4-シクロヘキシリデ に隣接する有機薄膜層に含有させる金属としては、陰極 10 ンメチンーフェニルーN-4-(p-トリルビニル)フ ェニルアミンの合成

> p-トルイジンの代わりに4-アミノー4'-メチルス チルベンを用いる他は合成例1と同様の手法により、目 的のN-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N -4-(p-トリルビニル)フェニルアミンを得た。

> 【0056】(合成例3) N-4-(4-(シクロへ キシリデンメチン)フェニルビニル)フェニル-N-p ートリルアミンの合成

4-ブロモベンジルブロマイドの代わりに、4-ブロモ 20 - 4' - ブロモメチルスチルベンを用いる他は合成例 1 と同様の手法により、目的のN-4-(4-(シクロへ キシリデンメチン)フェニルビニル)フェニルーN-p ートリルアミンを得た。

【0057】(合成例4) N-4-(2, 2-ビス (4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニ ル) フェニル-N-p-トリルアミンの合成 4-ブロモベンジルブロマイドの代わりに、4-(2, 2-ビス(4-ブロモメチルフェニル)ビニル)フェニ ルブロミドを用い、亜リン酸トリエチル及びシクロヘキ サノン、水素化ナトリウムを2等量ずつ用いる他は合成 例 1 と同様の手法により、目的のN-4-(2, 2-ビ ス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニ ル) フェニル-N-p-トリルアミンを得た。

(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニ ル)フェニルーN-フェニルアミンの合成 p-トルイジンの代わりにアニリンを用いる他は合成例 5と同様の手法により目的のN-4-(2, 2-ビス (4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニ

【0058】(合成例5) N-4-(2, 2-ビス

【0059】(合成例6) 化合物(1)の合成 1、4-ジブロモナフタレン、2等量のN-4-シクロ ヘキシリデンメチンーフェニルーN-p-トリルアミ ン、2等量の炭酸カリウム、銅紛及びニトロベンゼンを 3つロフラスコに入れ、200℃で30時間攪拌した。 反応終了後、トルエンを加えてろ過し、無機物を除い た。トルエン及びニトロベンゼンを減圧下で留去し、残 さを常法に従い分離精製して目的の化合物(1)を得

50 【0060】(合成例7) 化合物(2)の合成

N-4-シクロへキシリデンメチンーフェニル-N-pートリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4-(シクロへキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例 6 と同様の手法により目的の化合物(2)を得た。

【0061】(合成例8) 化合物(3)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチンーフェニルーN-pートリルアミンの代わりにN-4-シクロヘキシリデンメチンーフェニルーN-4-(pートリルビニル)フェニルアミンを用いる他は合成例6と同様の手法により目10的の化合物(3)を得た。

【0062】(合成例9) 化合物(4)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p-トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例6と同様の手法により目的の化合物(4)を得た。

【0063】(合成例10) 化合物(5)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p -トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4 20-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-フェニルアミンを用いる他は合成例6と同様の手法により目的の化合物(5)を得た。

【0064】(合成例11) 化合物(6)の合成1,4-ジブロモナフタレンの代わりに、2,3-ジメチル-1,4ジブロモナフタレンを用いる他は、合成例6と同様の手法により、目的の化合物(6)を得た。【0065】(合成例12) 化合物(7)の合成N-4-シクロヘキシリデンメチンーフェニルーN-pートリルアミンの代わりにN-4-(2,2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニルーN-p-トリルアミンを用いる他は合成例11と同様の手法により目的の化合物(7)を得た。

【0066】(合成例13) 化合物(9)の合成 N-4-2クロヘキシリデンメチン-7ェニル-N-pートリルアミンの代わりにN-4-(2,2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例11と同様の手法により目的の化合物(9)を得た。

【0067】(合成例14) 化合物(10)の合成 1,4-ジブロモナフタレンの代わりに、9,10-ジ ブロモアントラセンを用いる他は、合成例6と同様の手 法により、目的の化合物(10)を得た。

【0068】(合成例15) 化合物(11)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-pートリルアミンの代わりにN-4-(2,2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例14と同様の手法により目的の化合物(11)を得た。

【0069】(合成例16) 化合物(13)の合成

N-4-シクロヘキシリデンメチンーフェニルーN-pートリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニルーN-p-トリルアミンを用いる他は合成例14

と同様の手法により目的の化合物 (13) を得た。 【0070】(合成例17) 化合物 (14) の合成

1, 4 - ジブロモナフタレンの代わりに、6、13 - ジブロモペンタセンを用いる他は、合成例6と同様の手法により、目的の化合物(14)を得た。

【0071】(合成例18) 化合物(15)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p-トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例17と同様の手法により目的の化合物(15)を得た。

【0072】(合成例19) 化合物(17)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチンーフェニル-N-pートリルアミンの代わりにN-4-(2,2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル<math>-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例17と同様の手法により目的の化合物(17)を得た。

【0073】(合成例20) 化合物(18)の合成 1,4-ジブロモナフタレンの代わりに、3,9-ジブロモペリレンを用いる他は、合成例6と同様の手法により、目的の化合物(18)を得た。

【0074】(合成例21) 化合物(19)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p-トリルアミンの代わりにN-4-(2,2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例20と同様の手法により目的の化合物(19)を得た。

【0075】(合成例22) 化合物(21)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p-トリルアミンの代わりにN-4-(2,2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例20と同様の手法により目的の化合物(21)を得た。

【0076】(合成例23) 化合物(22)の合成 1,4-ジブロモナフタレンの代わりに、ジブロモベン 40 ゾ[a]ペリレンを用いる他は、合成例6と同様の手法 により、目的の化合物(22)を得た。

【0077】(合成例24) 化合物(23)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p-トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4-(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例23と同様の手法により目的の化合物(23)を得た。

【0078】(合成例25) 化合物(25)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p 50 -トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4

- (シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニルーNーpートリルアミンを用いる他は合成例23 と同様の手法により目的の化合物(25)を得た。

【0079】(合成例26) 化合物(26)の合成 1, 4 - ジブロモナフタレンの代わりに、8, 16 - ジ ブロモジベンゾ [a, j] ペリレンを用いる他は、合成 例6と同様の手法により、目的の化合物(26)を得 た。

【0080】(合成例27) 化合物(27)の合成 ートリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4) – (シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例26 と同様の手法により目的の化合物(27)を得た。

【0081】(合成例28) 化合物(29)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p -トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4))(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ エニルーN-p-トリルアミンを用いる他は合成例26 と同様の手法により目的の化合物(29)を得た。

【0082】(合成例29) 化合物(30)の合成 1. 4 - ジブロモナフタレンの代わりに、7. 14 - ジ ブロモビスアンスレンを用いる他は、合成例6と同様の 手法により、目的の化合物(30)を得た。

【0083】(合成例30) 化合物(31)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p ートリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4) - (シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニルーN-p-トリルアミンを用いる他は合成例29 と同様の手法により目的の化合物(31)を得た。

【0084】(合成例31) 化合物(33)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p ートリルアミンの代わりにN-4-(2、2-ビス(4) (シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニル-N-p-トリルアミンを用いる他は合成例29 と同様の手法により目的の化合物(33)を得た。

【0085】(合成例32) 化合物(34)の合成 1. 4 - ジブロモナフタレンの代わりに、10、10' ージブロモー9,9'ービアンスリルを用いる他は、合 成例6と同様の手法により、目的の化合物(34)を得 40 た。

【0086】(合成例33) 化合物(35)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p ートリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4) - (シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニルーN-p-トリルアミンを用いる他は合成例32 と同様の手法により目的の化合物(35)を得た。

【0087】(合成例34) 化合物(37)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p ートリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4 50したところ、120cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。

(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニルーN-p-トリルアミンを用いる他は合成例32 と同様の手法により目的の化合物(37)を得た。

【0088】(合成例35) 化合物(38)の合成 1. 4 - ジブロモナフタレンの代わりに、9, 10 - ビ ス(4-ブロモ-1-ナフチル)アントラセンを用いる 他は、合成例6と同様の手法により、目的の化合物(3 8)を得た。

【0089】(合成例36) 化合物(39)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p -トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4))– (シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニルーN-p-トリルアミンを用いる他は合成例35 と同様の手法により目的の化合物(39)を得た。

【0090】(合成例37) 化合物(41)の合成 N-4-シクロヘキシリデンメチン-フェニル-N-p -トリルアミンの代わりにN-4-(2, 2-ビス(4))(シクロヘキシリデンメチン)フェニル)ビニル)フ ェニルーNーロートリルアミンを用いる他は合成例35 20 と同様の手法により目的の化合物(41)を得た。

【0091】以下、実施例1~98においては、上記で 合成した化合物を用い、これらの化合物、あるいはこれ らの化合物と正孔輸送材料との混合薄膜、あるいはこれ らの化合物と電子輸送材料との混合薄膜により有機 E L 素子の発光層を構成した例について説明する。

【0092】(実施例1)図1に示した構造の有機EL 素子を作製した。ガラス基板上にITOをスパッタリン グ法によって、シート抵抗が20Ω/□になるように成 膜し、陽極とした。その上に発光層として、化合物

(1) を真空蒸着法にて40nm形成した。次に、陰極 としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法にて200n m形成して、有機EL素子を作製した。この素子に直流 電圧を5V印加したところ、90cd/m゚の発光が得 られた。

【0093】(実施例2)発光材料として、化合物 (2) を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有 機EL素子をした。この素子に直流電圧を5V印加した ところ、110 c d/m の発光が得られた。

【0094】(実施例3)発光材料として、化合物 (3)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有 機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加 したところ、100 c d/m<sup>4</sup>の発光が得られた。

【0095】(実施例4)発光材料として、化合物 (4)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有 機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加 したところ、140cd/m゚の発光が得られた。

【0096】(実施例5)発光材料として、化合物 (5)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有 機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加

【0097】(実施例6)発光材料として、化合物 (6)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有 機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加 したところ、80 c d/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0098】(実施例7)発光材料として、化合物 (7)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有 機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加 したところ、130 c d/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0099】(実施例8)発光材料として、化合物 (9) を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有 機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加 したところ、140cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0100】(実施例9)発光材料として、化合物(1 0)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、有機 EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加し たところ、 $110 c d/m^2$  の発光が得られた。 【0101】(実施例10)発光材料として、化合物 (11)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、160cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 20 【0102】(実施例11)発光材料として、化合物 (13)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、 $200 \text{ c d/m}^2$  の発光が得られた。 【0103】(実施例12)発光材料として、化合物 (14)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、100cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0104】(実施例13)発光材料として、化合物 (15)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、140 c d/m²の発光が得られた。 【0105】(実施例14)発光材料として、化合物 (17)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、150cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0106】(実施例15)発光材料として、化合物 (18)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、90cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0107】(実施例16)発光材料として、化合物 (19)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、120cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0108】(実施例17)発光材料として、化合物 (21)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、130cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0109】(実施例18)発光材料として、化合物

(22)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、

有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、 $80 \text{ c d/m}^2$ の発光が得られた。 【0110】(実施例19)発光材料として、化合物 (23)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、100 c d/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0111】(実施例20)発光材料として、化合物 (25)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V印 加したところ、120cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0112】(実施例21)発光材料として、化合物 (26)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、100cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0113】(実施例22)発光材料として、化合物 (27)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、110cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0114】(実施例23)発光材料として、化合物 (29)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、130cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0115】(実施例24)発光材料として、化合物 (30)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を5 V 印 加したところ、80 c d/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0116】(実施例25)発光材料として、化合物 (31)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、100cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0117】(実施例26)発光材料として、化合物 (33)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、 $130 \text{ c d/m}^2$  の発光が得られた。 【0118】(実施例27)発光材料として、化合物 (34)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、110 c d/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0119】(実施例28)発光材料として、化合物 (35)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印 加したところ、130cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0120】(実施例29)発光材料として、化合物 (37)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 加したところ、140cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。 【0121】(実施例30)発光材料として、化合物 (38)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V 印 50 加したところ、100cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。

【0122】(実施例31)発光材料として、化合物 (39)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 5 V印 加したところ、 $140cd/m^2$ の発光が得られた。

【0123】(実施例32)発光材料として、化合物 (41)を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を5 V 印 加したところ、 $150 \text{ c d/m}^2$ の発光が得られた。

【0124】(実施例33) ガラス基板上にITOをス パッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□にな るように成膜し、陽極とした。その上に化合物(9)の クロロホルム溶液を用いたスピンコート法により 40 n mの発光層を形成した。次に、陰極としてマグネシウム -銀合金を真空蒸着法により200nm形成して、有機 EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加し たところ、 $90 \text{ c d/m}^2$  の発光が得られた。

【0125】(実施例34)図2に示した構造の有機E L素子を作製した。ガラス基板上にITOをスパッタリ ング法によって、シート抵抗が20Ω/□になるように 成膜し、陽極とした。その上に正孔輸送層として、N, N' -ジフェニル-N, N' -ビス(3-メチルフェニ  $(1, 1' - \forall 7 + \forall 1) - 4, 4' - \forall 7 + \forall 7 + \forall 1$ [52] を真空蒸着法にて50nm形成した。次に、発 光層として、化合物(1)を真空蒸着法にて40 nm形 成した。

【0126】次に、電子輸送層として2-(4-ビフェ = (4 - t - ) (4 - t - ブチルフェニル) - 1, 3, 4-オキサジアゾール「57]を真空蒸着法にて20n m形成した。次に、陰極としてマグネシウムー銀合金を 真空蒸着法によって200nm形成して、有機EL素子 30 を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したとこ ろ、 $3050cd/m^2$ の発光が得られた。

【0127】(実施例35)発光材料として、化合物 (2)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 印加したところ、3870 c d/m<sup>2</sup>の発光が得られ

【0128】(実施例36)発光材料として、化合物 (3)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、 有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 40 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 印加したところ、3760cd/m<sup>2</sup>の発光が得られ た。

【0129】(実施例37)発光材料として、化合物 (4)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 印加したところ、4620 c d / m<sup>2</sup> の発光が得られ た。

【0130】(実施例38)発光材料として、化合物 (5)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 1 0 V 50 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 1

印加したところ、4250cd/m<sup>2</sup>の発光が得られ た。

【0131】(実施例39)発光材料として、化合物 (6)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 印加したところ、3120cd/m<sup>2</sup>の発光が得られ

【0132】(実施例40)発光材料として、化合物 (7)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 印加したところ、4040cd/m<sup>2</sup>の発光が得られ teo

【0133】(実施例41)発光材料として、化合物 (9) を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 印加したところ、4890cd/m<sup>2</sup>の発光が得られ

【0134】(実施例42)発光材料として、化合物 (10)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、3810 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら

【0135】(実施例43)発光材料として、化合物 (11)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、4 4 3 0 c d/m'の発光が得ら

【0136】(実施例44)発光材料として、化合物 (13)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、5710 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら

【0137】(実施例45)発光材料として、化合物 (14) を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、3 1 4 0 c d / m の発光が得ら れた。

【0138】(実施例46)発光材料として、化合物 (15)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 0 V 印加したところ、4 0 2 0 c d / m<sup>2</sup> の発光が得ら

【0139】(実施例47)発光材料として、化合物 (17)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、4360 c d / m²の発光が得ら れた。

【0140】(実施例48)発光材料として、化合物 (18) を用いる以外は実施例34と同様の操作を行

0 V印加したところ、3 4 7 0 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら れた。

【0141】(実施例49)発光材料として、化合物 (19)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、4270 c d / m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0142】(実施例50)発光材料として、化合物 (21)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、5230 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら れた。

【0143】(実施例51)発光材料として、化合物 (22)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、2960 c d/m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0144】(実施例52)発光材料として、化合物 (23)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 1 0 V印加したところ、3630 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら れた。

【0145】(実施例53)発光材料として、化合物 (25)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、4370 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら

【0146】(実施例54)発光材料として、化合物 (26)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 OV印加したところ、3150cd/m<sup>2</sup>の発光が得ら

【0147】(実施例55)発光材料として、化合物 (27)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、4 1 1 0 c d / m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0148】(実施例56)発光材料として、化合物 (29) を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、4740 c d/m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0149】(実施例57)発光材料として、化合物 (30)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、2860 c d/m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0150】(実施例58)発光材料として、化合物 (31)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行

0 V 印加したところ、3320 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら れた。

【0151】(実施例59)発光材料として、化合物 (33)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、4210 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら れた。

【0152】(実施例60)発光材料として、化合物 (34)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 10 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を 1 0 V 印加したところ、3 3 7 0 c d / m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0153】(実施例61)発光材料として、化合物 (35)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V 印加したところ、4 2 5 0 c d / m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0154】(実施例62)発光材料として、化合物 (37)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 20 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、5 4 1 0 c d /m²の発光が得ら れた。

【0155】(実施例63)発光材料として、化合物 (38)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、3290 c d/m<sup>4</sup>の発光が得ら

【0156】(実施例64)発光材料として、化合物 (39)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 30 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、4030 c d/m<sup>2</sup>の発光が得ら

> 【0157】(実施例65)発光材料として、化合物 (41)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、4970 c d/m<sup>2</sup> の発光が得ら

【0158】(実施例66)正孔輸送層としてN. N 'ージフェニルーN−N−ビス(1−ナフチル)−1. 1'-ビフェニル)-4,4'-ジアミン[53]を、 電子輸送層としてビス {2-(4-t-ブチルフェニ ン[58]を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機 E L素子を作製した。この素子に直流電圧を1 O V 印加したところ、3 1 3 0 c d / m<sup>2</sup> の発光が得ら れた。

【0159】(実施例67)正孔輸送層として[54] を、発光層として化合物(4)を、電子輸送層として [61]を用いる以外は実施例34と同様の操作を行 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 50 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1

0 V印加したところ、3 9 3 0 c d /m の発光が得られた。

【0160】(実施例68)正孔輸送層として [55] を、発光層として化合物 (21) を、電子輸送層として [62] を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、4260 c d / m  $^2$  の発光が得られた。

【0161】(実施例69)図2に示した構造の有機EL素子を作製した。ガラス基板上にITOをスパッタリ 10ング法によって、シート抵抗が20Ω/□になるように成膜し、陽極とした。その上に正孔輸送層として、[53]を真空蒸着法にて50nm形成した。その上に発光層として[53]と化合物(18)を1:10の重量比で共蒸着して作製した薄膜を50nm形成した。

【0162】次に、電子輸送層として2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール [57] を真空蒸着法にて20 nm形成した。次に、陰極としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法によって200 nm形成して、有機EL素子20を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、3700 cd/m²の発光が得られた。

【0163】 (実施例70) 化合物 (18) の代わりに 化合物 (23) を用いる以外は実施例69と同様の操作 を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧 を10V印加したところ、3690cd $/m^2$ の発光が 得られた。

【0164】(実施例71)化合物(18)の代わりに化合物(37)を用いる以外は実施例69と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、5010cd/m²の発光が得られた。

【0165】(実施例72)図4に示した構造の有機EL素子を作製した。ガラス基板上にITOをスパッタリング法によって、シート抵抗が20 $\Omega$ / $\square$ になるように成膜し、陽極とした。その上に発光層としてN,N'ージフェニルーNーNービス(1ーナフチル)ー1,1'ービフェニル)ー4,4'ージアミン[53]と化合物(22)を1:10の重量比で共蒸着して作製した薄膜を50nm形成した。

【0166】次いで、電子輸送層として [59] を真空 蒸着法にて50 n m形成した。次に、陰極としてマグネシウムー銀合金を200 n m形成して、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V 印加したところ、2910 c d / m  $^2$  の発光が得られた。

【0167】 (実施例73) 化合物 (22) の代わりに 化合物 (27) を用いる以外は実施例72と同様の操作 を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧 を 10 V 印加したところ、3680 c d /m  $^2$  の発光が 得られた。

002 10

【0168】 (実施例74) 化合物 (22) の代わりに 化合物 (37) を用いる以外は実施例72と同様の操作 を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧 を 10 V 印加したところ、4020 c d / m  $^2$  の発光が 得られた。

42

【0169】 (実施例75) 化合物 (22) の代わりに 化合物 (41) を用いる以外は実施例72と同様の操作 を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧 を10 V印加したところ、3030 c d  $/m^2$  の発光が 得られた。

【0170】(実施例76)発光層として化合物(18)を真空蒸着法により40nm形成する以外は実施例72と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、3100cd/ $m^2$ の発光が得られた。

【0171】 (実施例77) 発光層として化合物 (7) を真空蒸着法により 40 n m形成する以外は実施例72 と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、3680 c d/m² の発光が得られた。

【0172】(実施例78)発光層として化合物(21)を真空蒸着法により40nm形成する以外は実施例72と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、4340c d/m²の発光が得られた。

【0173】(実施例79)ガラス基板上にITOをスパッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□になるように成膜し、陽極とした。その上に化合物(12)とN,N'ージフェニルーNーNービス(1ーナフチル)ー1,1'ービフェニル)ー4,4'ージアミン[53]をモル比で1:10の割合で含有するクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により40nmの発光層を形成した。次に[60]を真空蒸着法により50nmの電子輸送層を形成し、その上に陰極としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法により200nm形成して、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1870cd/m²の発光が得られた

【0174】(実施例80)図3に示した構造の有機E 1 上素子を作製した。ガラス基板上にITOをスパッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□になるように成膜し、陽極とした。その上に正孔輸送層としてN,N'ージフェニルーNーNービス(1ーナフチル)ー1,1'ービフェニル)ー4,4 'ージアミン[53]を真空蒸着法にて50nm形成した。次に、発光層として[61]と化合物(10)とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を50nm形成した。次に、陰極としてマグネシウムー銀合金を200nm形成して、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したと50ころ、3070cd/m²の発光が得られた。

【0175】(実施例81)発光層として、[61]と化合物(19)とを20:1の重量比で真空共蒸着した50nmの膜を用いる以外は実施例80と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、3490 c d / m $^2$  の発光が得られた。

【0176】 (実施例82) 化合物 (19) の代わりに 化合物 (33) を用いる以外は実施例81と同様の操作 を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧 を10 V 印加したところ、3740 c d / m  $^2$  の発光が 得られた。

【0177】(実施例83)化合物(19)の代わりに化合物(14)を用いる以外は実施例81と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、2870 c d / m  $^2$  の発光が得られた。

【0178】 (実施例84) 化合物 (19) の代わりに 化合物 (35) を用いる以外は実施例81と同様の操作 を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧 を10V印加したところ、3550 c d  $/m^2$  の発光が 得られた。

【0179】 (実施例85) 化合物 (19) の代わりに 化合物 (29) を用いる以外は実施例81と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧 を10 V 印加したところ、3890 c d / m  $^2$  の発光が 得られた。

【0180】 (実施例86) 正孔輸送層としてN, N'ージフェニルーN, N'ービス (3-メチルフェニル)ー [1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン <math>[52] を、発光層として [63] と化合物 (41) とを20:1の重量比で真空共蒸着して作製した膜を用いる以外は実施例 42 と同様の操作を行い、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、3990 c d/ $m^2$  の発光が得られた。

【0181】(実施例87)正孔輸送層として化合物 (6)を、発光層として[63]を用いる以外は実施例 34と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1120cd/m²の発光が得られた。

【0182】(実施例88)正孔輸送材料として、化合 40物(11)を用いる以外は実施例87と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1550cd/m²の発光が得られた。

【0183】(実施例89)正孔輸送材料として、化合物(41)を用いる以外は実施例87と同様の操作を行い、有機 E L素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V 印加したところ、1930 c d  $/m^2$  の発光が得られた。

【0184】(実施例90)正孔輸送層としてN, N'

4

ージフェニルーN-N-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル)-4,4'-ジアミン [53] を、 発光層として [63] を、電子輸送層として化合物(3 8)を用いる以外は実施例34と同様の操作を行い、有 機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印 加したところ、800cd/m<sup>2</sup>の発光が得られた。

【0185】(実施例91)電子輸送層として、化合物 (7)を用いる以外は実施例90と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 印加したところ、940cd/m²の発光が得られた。 【0186】(実施例92)電子輸送層として、化合物 (13)を用いる以外は実施例90と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、960cd/m²の発光が得られた

【0187】(実施例93)ガラス基板上にITOをスパッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□になるように成膜し、陽極とした。このITO基板をアルカリ洗浄液、次いでイソプロピルアルコールを用いて洗浄した。洗浄したITO基板をXe2紫外線照射装置にセットし、基板に172nmの紫外線を3分間照射した。この基板上に正孔輸送層として、N,N'ージフェニルーN,N'ービス(3-メチルフェニル)ー[1,1'ービフェニル]ー4,4'ージアミン[52]を真空蒸着法にて50nm形成した。次に、発光層として、化合物(1)を真空蒸着法にて40nm形成した。

【0188】次に、電子輸送層として2-(4-ii) ニリル)-5-(4-ii) を真空蒸着法にて20n m形成した。次に陰極としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法によって200n m形成して、有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、5630 c d/m² の発光が得られた。

【0189】(実施例94)ガラス基板上にITOをスパッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□になるように成膜し、陽極とした。このITO基板をアルカリ洗浄液、次いでイソプロピルアルコールを用いて洗浄した。洗浄したITO基板をXez紫外線照射装置にセットし、基板に172nmの紫外線を3分間照射した。その上に発光層としてN,N'ージフェニルーNーNービス(1ーナフチル)ー1,1'ービフェニル)ー4,4'ージアミン[53]と化合物(37)を1:10の重量比で共蒸着して作製した薄膜を50nm形成した。【0190】次いで、電子輸送層として[59]を真空蒸着法にて50nm形成した。次に、陰極としてマグネシウムー銀合金を200nm形成して、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、4960cd/m²の発光が得られた。

【0191】(実施例95)ガラス基板上にITOをス 50 パッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□にな

るように成膜し、陽極とした。このITO基板をアルカ リ洗浄液、次いでイソプロピルアルコールを用いて洗浄 した。洗浄した I T O 基板を X e 2 紫外線照射装置にセ ットし、基板に172nmの紫外線を3分間照射した。 その上に発光層として化合物(21)を真空蒸着法にて 50 n m 形成した。

【0192】次いで、電子輸送層として [59] を真空 蒸着法にて50nm形成した。次に、陰極としてマグネ シウムー銀合金を200nm形成して、有機EL素子を 作製した。この素子に直流電圧を10 V 印加したとこ ろ、5330 c d / m<sup>2</sup> の発光が得られた。

【0193】(実施例96)ガラス基板上にITOをス パッタリング法によって、シート抵抗が200/□にな るように成膜し、陽極とした。その上に正孔輸送層とし て、[53]を真空蒸着法にて50nm形成した。その 上に発光層として [53] と化合物(2)を1:10の 重量比で共蒸着して作製した薄膜を50 nm形成した。 次に、電子輸送層として2-(4-ビフェニリル)-5 アゾール [57] を真空蒸着法にて20nm形成し、そ の後 [57] とセシウムを重量比10:1の共蒸着で5 nm形成した。次に、陰極としてマグネシウムー銀合金 を真空蒸着法によって200nm形成して、有機EL素 子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したと ころ、3890 c d/m<sup>2</sup> の発光が得られた。

【0194】(実施例97)ガラス基板上にITOをス パッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□にな るように成膜し、陽極とした。その上に正孔輸送層とし てN, N 'ージフェニルーNーNービス(1ーナフチ (1)[53]を真空蒸着法にて50nm形成した。次に、発 光層として化合物(37)を真空蒸着した膜を50nm 形成した。その後(37)とセシウムを重量比10:1 の共蒸着で5 n m形成した。次に陰極としてマグネシウ ムー銀合金を真空蒸着法によって200nm形成して、 有機 E L 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V 印加したところ、4750 c d/m²の発光が得られ た。

\*【0195】(実施例98)ガラス基板上にITOをス パッタリング法によって、シート抵抗が20Ω/□にな るように成膜し、陽極とした。このITO基板をアルカ リ洗浄液、次いでイソプロピルアルコールを用いて洗浄 した。洗浄した I T O基板を X e 2 紫外線照射装置にセ ットし、基板に172nmの紫外線を3分間照射した。 その上に発光層として化合物(19)を真空蒸着法にて 50 nm形成した。その後(19)とセシウムを重量比 10:1の共蒸着で5nm形成した。次に、陰極として 10 マグネシウムー銀合金を真空蒸着法によって200nm 形成して、有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、2030cd/m<sup>2</sup>の発光 が得られた。

【0196】以上、実施例1~98に示すように、本発 明によれば、高輝度な有機EL素子を提供できることが 判明した。

### [0197]

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明の化合物 を、有機エレクトロルミネッセンス素子を構成する有機 薄膜層のうち少なくとも一層に用いることにより、成膜 プロセスに制限無く、発光特性に優れた有機エレクトロ ルミネッセンス素子を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、本発明の有機エレクトロルミネッセ ンス素子の断面図である。

【図2】 図2は、本発明の有機エレクトロルミネッセ ンス素子の断面図である。

【図3】 図3は、本発明の有機エレクトロルミネッセ ンス素子の断面図である。

【図4】 図4は、本発明の有機エレクトロルミネッセ ンス素子の断面図である。

# 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子輸送層
- 6 陰極

【図3】 【図4】 【図1】 【図2】

フロントページの続き

(51) Int.C1.<sup>7</sup>

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H O 5 B 33/26

H O 5 B 33/26

Z

(72)発明者 多田 宏

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 小田 敦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB18 CA01 CB01

DAO1 DBO3 EBOO